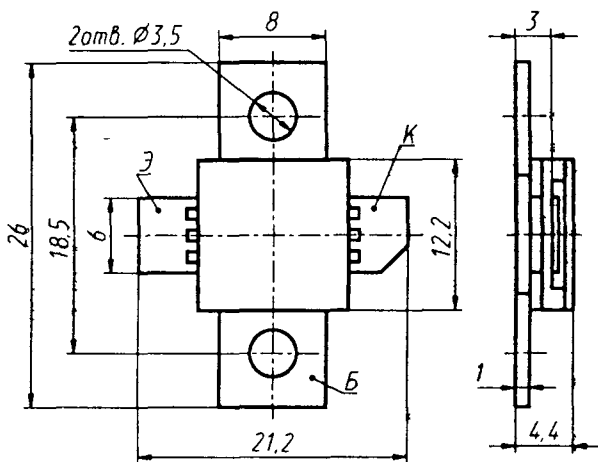


Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* генераторный. Предназначен для применения в широкополосных усилителях мощности, умножителях частоты и автогенераторах в схеме с общей базой в диапазоне частот 0,7...1,4 ГГц при напряжении питания 28 В в непрерывном

режиме и 35...40 В в импульсном режиме. Выпускается в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Внутри корпуса имеются двухзвенные LC-звенья на входе и выходе транзистора. Тип прибора указывается на корпусе. Допускается нанесение маркировки в этикетке, а также на упаковочной таре, при этом маркировка на транзистор не наносится.

Масса транзистора не более 5 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



Электрические параметры

Выходная мощность на $f = 1,3$ ГГц при $U_{КБ} = 28$ В, $K_{yP} = 6$ дБ, не менее	50 Вт
типичное значение	55 Вт
Выходная мощность на $f = 1,3$ ГГц при $U_{КБ} = 20$ В, $K_{yP} = 4$ дБ, не менее	30 Вт
Коэффициент полезного действия коллектора на $f = 1,3$ ГГц при $U_{КБ} = 28$ В, $K_{yP} = 6$ дБ, не менее	45%
типичное значение	50%
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 50$ В, не более	100 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 3,5$ В, не более	30 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база ¹	
при $T_K = -60...+25\text{ °C}$	50 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	3,5 В
Потенциал статического электричества	1000 В
Постоянный ток коллектора	5 А
Импульсный ток коллектора:	
при $t_{и} = 20\text{ мкс}$, $Q = 10$	10 А
при $t_{и} = 1000\text{ мкс}$, $Q = 10$ или $t_{и} = 500\text{ мкс}$, $Q = 5$	7 А
Постоянный ток базы	2 А
Средняя рассеиваемая мощность коллектора ²	
в динамическом режиме при $T_K = +25\text{ °C}$	75 Вт
Температура p - n перехода	+175 °C
Тепловое сопротивление переход—корпус	2 °C/Вт
Температура окружающей среды	-60... $T_K =$ = +125 °C

¹ При понижении температуры корпуса от +25 до -60 °C $U_{кб, макс}$ снижается линейно до 45 В.

² При $T_K > +25\text{ °C}$ максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{к, ср, макс} = (175 - T_K)/2, \text{ Вт.}$$

При работе транзистора в импульсном режиме при $t_{и} = 1000\text{ мкс}$, $Q = 10$ или $t_{и} = 500\text{ мкс}$, $Q = 5$ напряжение питания должно быть не более 35 В, при $t_{и} = 20\text{ мкс}$, $Q = 10$ не более 40 В.

Применение транзистора в статическом режиме, в том числе в режиме класса «А» не допускается.

Транзисторы пригодны для монтажа в аппаратуре паяльником. Расстояние от корпуса до места лужения и пайки не менее 3 мм, температура припоя $+260 \pm 10\text{ °C}$, время пайки не более 3 с. Допускается пайка выводов на расстоянии 1 мм от корпуса, при этом температура пайки не должна превышать +150 °C. Допускается сварка выводов на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса, при этом температура корпуса не должна превышать +150 °C.